04

Особенности микроволнового излучения при раскачке "веерной" неустойчивости в омически нагретой плазме и взаимодействии ускоренных электронов с магнитными пробками токамака ФТ-2

© В.В. Рождественский, С.В. Крикунов, С.И. Лашкул, Л.А. Есипов, А.Б. Алтухов, Д.В. Куприенко

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург E-mail: V.V.Rozhdestvensky@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 18 июня 2013 г.

Представлены результаты наблюдения аномально интенсивного микроволнового излучения (МИ) в диапазоне электронных плазменных частот 10-20 GHz, возникающего непрерывно в течение омического нагрева умеренно плотной плазмы токамака ФТ-2. Его появление связано как с развитием в плазме "веерной" неустойчивости, так и с наличием значительных локальных пробок тороидального магнитного поля. Обнаружено, что МИ сопровождается короткими "гигантскими", а также менее интенсивными вспышками в диапазоне магнитного уширения 1-й гармоники электронной циклотронной частоты 57-75 GHz. Как известно, последние возникают при "мазерном" усилении синхротронного излучения ускоренных электронов, взаимодействующих с гармониками локальных магнитных пробок в режиме циклотронного авторезонанса. В наших условиях, благодаря нелинейной трансформации плазменных волн, возбуждаемых при раскачке "веерной" неустойчивости, в электромагнитные, появляется коллективное излучение (КИ). Поэтому аномально высокий уровень МИ обусловлен, по-видимому, "мазерным" усилением КИ, а "гигантские" вспышки возникают при подходящих условиях в процессе самовозбуждения мазера-усилителя.

На ряде токамаков [1–4] обнаружены интенсивные короткие вспышки микроволнового излучения (МИ), возникающие при взаимодействии свободно ускоренных электронов (УЭ) с гармониками локальных магнитных пробок на периферии плазмы в режиме циклотронного авторезонанса [2–7]. В таких условиях возможно "мазерное" усиление

43

синхротронного излучения (СИ) в полосе частот, соответствующей ширине циклотронного авторезонанса. Интенсивность вспышек определяется плотностью и энергией ускоренных электронов, глубиной локальных магнитных пробок. Длительность вспышек зависит от времени существования резонансных условий в плазме.

Впервые вспышки МИ такой природы были обнаружены на начальной стадии омического нагрева (OH) плазмы в токамаке ASDEX-U в диапазоне частот 100-120 GHz при относительно малой глубине магнитных пробок, $\Delta B_t/B_t \sim 0.1\%$, число тороидальных катушек $N_t = 16$, в условиях, неблагоприятных для раскачки "веерной" неустойчивости, [1,2,8]. Аналогичные вспышки МИ были недавно зарегистрированы на токамаке ФТ-2 с существенно большей глубиной магнитных пробок, $\Delta B_t/B_t \sim 10\%$ при $\dot{N_t}=24$, в экспериментах по генерации нижнегибридного тока увлечения (НГТУ) в омически нагретой (ОН) плазме [4,9]. При высокочастотной (ВЧ) накачке в плазме с относительно низкой плотностью $\langle n_e \rangle \sim (1-2) \cdot 10^{-13} \, {\rm cm}^{-3}$ появляются электроны, ускоренные нижнегибридной волной и вихревым электрическим полем до энергии масшатаба 8 MeV. Такие УЭ способны как раскачивать "веерную" неустойчивость, так и эффективно взаимодействовать с локальными магнитными пробками на периферии плазмы. При этом растет интенсивность СИ в диапазонах частот, соответствующих магнитному уширению 1-й и 2-й гармоник электронной циклотронной частоты (ЭЦЧ) тепловых электронов, 55-78 и 110-156 GHz и появляются короткие ~ 100 µs вспышки МИ за счет "мазерного" усиления СИ, распространяющегося в одном направлении с УЭ. Для регистрации МИ в этих экспериментах использовались 4 и 2 mm супергетеродинные радиометры (СГР) с пороговой чувствительностью $P_{th} \sim 10^{-12}$ W, со сверхразмерной линией передачи и круглой рупорной антенной, помещенной в разрядную камеру (РК) со стороны сильного магнитного поля. РК представляет собой тор, $R_0 = 0.55 \,\mathrm{m}$ и $a = 0.08 \,\mathrm{m}$, с гофрированными стенками, шаг гофрировки d = 8 mm. Оказалось, что появление вспышек МИ в течение ВЧ-импульса сопровождается дополнительным нагревом тепловых электронов в центральной области плазмы с $T_e(r=0)$ от 300 до 550 eV при мощности ВЧ-накачки $P_{\rm HV} \sim 90$ kW, [13]. Было высказано предположение, что дополнительный нагрев электронов инициирован поглощением интенсивных вспышек МИ и возросшего СИ в плазме.

Как известно, "мазерный " механизм генерации вспышек электромагнитного излучения (ЭМИ) связан с формированием в магнито-

активной плазме области с инверсной населенностью осцилляторов, обладающих большой поперечной энергией. Такие условия возникают в радиационных поясах магнитосфер Земли, планет, Солнца и звезд [10-12], а также в лабораторных плазменных ловушках с магнитными "пробками", в частности, токамаках с полоидальными и локальными "пробками" тороидального магнитного поля. В плазменных ловушках с "пробочной" конфигурацией магнитного поля происходит раскачка циклотронной неустойчивости запертыми и кинетических неустойчивостей — пролетными ускоренными электронами. Раскачка сопровождается "мазерным" усилением электромагнитных циклотронных и альфвеновских волн, а также электростатических плазменных колебаний с последующей нелинейной трансформацией в интенсивное ЭМИ, так называемое коллективное излучение (КИ) [13]. Аналогичные явления возникают, по-видимому, и в плазме лабораторных "пробкотронов" и токамаков при раскачке различных неустойчивостей ускоренными электронами.

Наблюдение аномально высокого уровня и интенсивных вспышек МИ на электронных плазменных и циклотронных частотах в течение ОН-плазмы на сферическом токамаке Глобус-М [3] и вспышек СИ в экспериментах по НГТУ на токамаке ФТ-2 [4] направило наши усилия на изучение природы "мазерных" эффектов, которые могут возникать в ОН-плазме, в частности, при раскачке "веерной" неустойчивости. В таких условиях на токамаке ФТ-2 исследовалось МИ в диапазоне магнитного уширения 1-й и 2-й гармоник ЭЦЧ тепловых электронов и в диапазоне электронных плазменных частот. Для регистрации низкочастотного МИ использовался приемник прямого усиления (ППУ) со сменными детекторными секциями для длин волн $\lambda = 3, 1.5, 0.8$ cm, чувствительность $P_{th} \sim 10^{-8}$ W и рупорной антенной, расположенной за стеклянным окном патрубка вне разрядной камеры со стороны слабого тороидального поля. Одновременно применялись также упомянутые выше СГР 4 и 2mm. Это позволило наблюдать появление и корреляцию вспышек МИ в диапазоне частот $f \sim 10-40 \,\mathrm{GHz}$ и в более высокочастотном диапазоне 69-75 GHz. В этих экспериментах впервые было обнаружено мощное МИ в диапазоне частот $\sim (10-40) \, \text{GHz}$ на стадии ОН-плазмы с умеренной плотностью $(1.2-4) \cdot 10^{13}$ cm⁻³. Кроме того, при $n > 2 \cdot 10^{13} \,\mathrm{cm}^{-3}$ для частот $f \leqslant 20 \,\mathrm{GHz}$ такое непрерывное в течение разряда излучение сопровождалось более интенсивными, "гигантскими" короткими вспышками. Полученные результаты представлены на рис. 1-3. На рис. 1, а-с представлены временные



Рис. 1. *а* — ток разряда и интенсивность жесткого рентгеновского излучения, HXR, для разрядов #44, #30 и #02; *b* — напряжение на обходе разрядной камеры в этих разрядах; *с* — средняя плотность плазмы.

зависимости некоторых плазменных параметров разрядов #44, #30 и #02 экспериментальной серии 06.06.2012 г., полученных в режиме OHплазмы разной плотности с разрядным током $I_{pl} \sim 30$ kA (рис. 1, *a*). На этом же рисунке показаны соответствующие зависимости интенсивности жесткого рентгеновского излучения (ЖРИ). На рис. 1, *b* приведены зависимости напряжения на обходе плазменного шнура U_{pl} для разрядов с различной плотностью $\langle n_e \rangle$, значения которой показаны на рис. 1, *c*. Как видно из рисунков, ЖРИ появляется по окончании роста разрядного тока, плотности плазмы и спада U_{pl} . Его интенсивность медленно растет практически до конца разряда. Оказалось, что в режиме с малой плотностью плазмы интенсивность



Рис. 2. Временные зависимости МИ ($\lambda = 3 \text{ cm}$), существующего в течение разряда и сопровождающегося интенсивными короткими вспышками. Данные приведены для разрядов: a - #44, b - #30 и c - #02.

ЖРИ и МГД-активность существенно уменьшаются. Это косвенно свидетельствует о подавлении МГД-возмущений при раскачке "веерной" неустойчивости токонесущими ускоренными электронами. На рис. 2, a-c представлены временные зависимости интенсивного МИ, $\lambda = 3$ сm, существующего в течение разряда при разной плотности плазмы (2.6, 2.4 и1.2)·10¹³ сm⁻³ и сопровождающегося интенсвными короткими вспышками МИ с длительностью ~ 70 μ s на разных стадиях разряда. Видно, что небольшое количество вспышек значительной интенсивности возникает на начальной стадии ОН, когда напряжение на обходе разрядной камеры достаточно велико, а плотность плазмы еще



Рис. 3. Временны́е зависимости СИ $\lambda = 4 \text{ mm}$ (*a*) и МИ $\lambda = 3 \text{ cm}$ (*b*), регистрация с помощью СГР и ППУ соответственно. На *b* сигнал уменышен в 10 раз по сравнению с данными *a*.

относительно мала. Существенно большее количество таких вспышек появляется на квазистационарной стадии разряда в менее плотной плазме $\langle n_e \rangle = 2.4 \cdot 10^{13} \, {\rm cm}^{-3}$ и при меньшем вихревом электрическом поле (рис. 2, b). В случае малой плотности плазмы $\langle n_e \rangle = 1.2 \cdot 10^{13} \, {\rm cm}^{-3}$ некоторое количество небольших вспышек возникало лишь в конце разряда (рис. 2, c). Такие же явления наблюдались и в более коротковолновом диапазоне $\lambda = 1.5 \, {\rm cm}$. Наиболее интенсивные вспышки были обнаружены при $\langle n_e \rangle = 2.4 \cdot 10^{13} \, {\rm cm}^{-3}$. В еще более коротковолновой области $\lambda = 0.8 \, {\rm cm}$ максимальный уровень МИ был при

 $\langle n_e \rangle = 1.5 \cdot 10^{13} \, {\rm cm}^{-3}$, а вспышки наблюдались только в течение подъема плазменного тока при $\langle n_e \rangle = 2.4 \cdot 10^{13} \, \mathrm{cm}^{-3}$ при больших значениях вихревого электрического поля. На рис. 3 представлены временные зависимости интенсивности МИ, регистрировавшиеся соответственно с помощью СГР, $\lambda = 4 \text{ mm}$, и ППУ, $\lambda = 3 \text{ cm}$. Можно видеть, что существенно разное по уровню $I(4 \text{ mm}) \ll I(3 \text{ cm})$ МИ сопровождается также разными по интенсивности короткими вспышками, возникающими одновременно. Это свидетельствует о раскачке "веерной" неустойчивости уже в начале разряда, а также о том, что в наших условиях происходит, по-видимому, не только "мазерное" усиление СИ и КИ в режиме циклотронного авторезонанса, но и генерация "гигантских" вспышек низкочастотного МИ, $f < 40 \,\text{GHz}$. Появление "гигантских" вспышек можно объяснить, например, самовозбуждением усилителя при слишком большом входном сигнале или коэффициенте усиления в условиях достаточного уровня "паразитной" положительной обратной связи. В токамаке ФТ-2 с большой глубиной локальных магнитных пробок и подходящими параметрами моноэнергетической быстрой компоненты ускоренных электронов в условиях многократного отражения КИ поверхностью "отсечки" и стенкой разрядной камеры мазер на циклотронном авторезонансе может перейти в режим самовозбуждения, когда генерируются короткие мощные вспышки МИ. При этом возможно одновременное появление вспышек как на частоте генерации, так и на ее гармониках. Таким образом, обнаруженные в наших экспериментах аномально высокий уровень и "гигантские" вспышки низкочатотного МИ могут быть обусловлены соответственно "мазерным" усилением КИ в режиме циклотронного авторезонанса и эффектом самовобуждения "мазерного" усилителя.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 10-02-00631, 11-02-00561, 13-08-00411 и гранта Правительства РФ согласно Постановлению № 220 по договору № 11.G34.31.0041 с Министерством образования и науки РФ.

Список литературы

- [1] Kurzan B., Steuer K.H., Suttrop W. // Rev. Sci. Instrum. 1997. V. 68. P. 423.
- [2] Kurzan B., Steuer K.H. // Phys. Rev. E. 1994. V. 55. P. 4608.
- [3] Ананьев А.С., Гусев В.К., Крикунов С.В. и др. // Proc. 12 Joint Workshop on ECE & ECRH, Aix-en-Provence, France, 13–16 May, 2002. Р. 191.

- [4] Лашкул С.И., Рождественский В.В., Алтухов А.Б. и др. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. В. 23. С. 69–76.
- [5] Lauren L., Rax J.M. // Europhys. Lett. 1990. V. 11. P. 219.
- [6] Russo A.J. // Nucl. Fusion. 1991. V. 31. P. 117.
- [7] Martin-Solis J.R., Esposito B., Sanchez R., Alvarez J.D. // Phys. Plasmas. 1999.
 V. 6. N 1. P. 238.
- [8] Параил В.В., Погуце О.П. Вопросы теории плазмы. В. 11 / Под ред. М.А. Леонтовича и Б.Б. Кадомцева. М.: Энергоиздат, 1982. С. 5–55.
- [9] Лашкул С.И., Алтухов А.Б., Гурченко А.Д. и др. // Физика плазмы. 2010. Т. 36. № 9. С. 803–814.
- [10] Беспалов П.А, Трахтенгерц В.Ю. Альфвеновские мазеры. Горький, 1986.
- [11] Трахтенгерц В.Ю., Демехов А.Г. // Природа. 2002. № 4.
- [12] Флейшман ГД., Мельников В.Ф. // УФН. 1998. Т. 168. № 12. С. 1265–1301.
- [13] Гинзбург В.Л., Железняков В.В. // АЖ. 1958. Т. 35. С. 694.